

УДК 681.326

**ИЗМЕНЕНИЕ
РЕНТГЕНОВСКИХ ФОТОЭЛЕКТРОННЫХ СПЕКТРОВ
ПЛЕНОК ЖЕЛЕЗОИТРИЕВОГО ГРАНАТА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКИ**

Г. А. Тюлиев, А. К. Чернакова, В. И. Шаповалов

Методом РФЭС исследованы изменения состава и химических связей на поверхности пленок железоитриевого граната в результате бомбардировки ионами аргона с энергией 1 кэВ. Анализ РФЭС спектров обнаружил частичную редукцию ионов железа Fe^{3+} до Fe^{2+} и Fe^0 . Состояние ионов иттрия и кислорода не меняется. Выявлен также слой с измененной стехиometрией толщиной приблизительно 40 Å.

В последнее время пленки железоитриевого граната (ЖИГ) ($\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$) приобретают все более широкое распространение как один из основных материалов функциональной электроники [1]. Для создания приборов спин-волновой электроники, магнитоэлектроники и магнитооптики во многих случаях используют ионную бомбардировку пленок ЖИГ с целью модификации свойств или получения определенных структур [2]. В результате ионной бомбардировки возможны изменения стехиометрии и химических связей на поверхности пленки ЖИГ [3]. Для обнаружения этих эффектов применим метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), позволяющий исследовать не только химический состав, но и по энергетическим сдвигам определять изменения в химических связях.

В настоящей работе изучены изменения спектров РФЭС пленок ЖИГ, наблюдаемые в процессе длительной бомбардировки ионами аргона. Эти изменения дают информацию об элементном составе и состоянии химических связей на поверхности пленок ЖИГ.

1. Методы исследования

Исследуемые образцы представляют собой монокристаллические пленки ЖИГ толщиной 16 мкм, выращенные методом жидкокристаллической эпитаксии на подложке из галлий-гадолиниевого граната. Перед исследованием образцы ЖИГ подвергались тщательной химической очистке — обезжиривались кипячением в толуоле, промывались в спирте и дистилированной воде.

РФЭС проводилась в анализирующей камере электронного спектрометра Эскалаб-II фирмы Вакуум Джениерейторс при давлении остаточных газов менее 10^{-8} Па. Источником рентгеновского излучения служил магне-зиевый анод — линия MgK_{α} с энергией фотонов $h\nu = 1253.6$ эВ. Регистрировались линии С (1s), Y (3d), Fe (3p), O (1s) и Fe (2p_{3/2}). Разрешающая способность энергоанализатора составляла 0.52 эВ, а полное разрешение по энергии достигало 1.06 эВ. Атомные соотношения компонентов находили исходя из интегральных интенсивностей с учетом поправок на сечение фотоионизации, глубину свободной утечки электронов и коэффициенты пропускания анализатора для электронов различных энергий. Бомбардировка ионами аргона Ar^+ производилась ионным источником AG-21 фирмы

Вакуум Дженнерейторс с холодным катодом. При ионной бомбардировке давление аргона составляло $3 \cdot 10^{-4}$ Па, энергия ионов 1 кэВ, плотность ионного тока $2 \text{ мкА}/\text{см}^2$. Угол бомбардировки равнялся 40° относительно нормали к поверхности. Чтобы избежать сильной зарядки поверхности пленки ЖИГ во время рентгеновского облучения и ионной бомбардировки поверхности, на образце с помощью серебряной пасты была установлена диафрагма из tantalа. Доказательством равномерного распределения за-

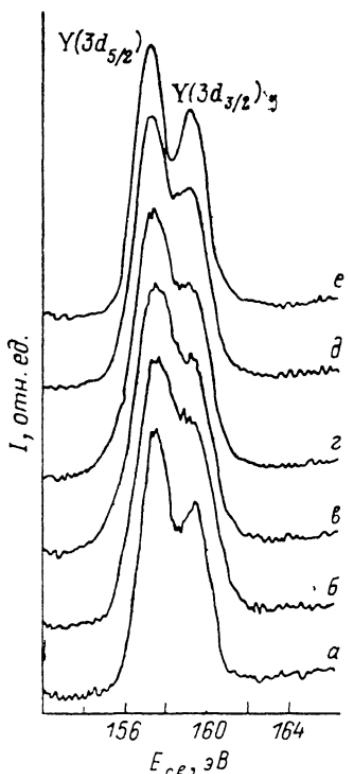


Рис. 1. РПЭС спектры линии Y (3d) на поверхности пленки ЖИГ до (a) и после ионной бомбардировки в течение 1 (b), 10 (c), 26 (d), 60 (e), 120 мин (e).

ряда на поверхности пленки ЖИГ является хорошее разделение линий Y ($3d_{5/2}$) и Y ($3d_{3/2}$) (рис. 1). Электронный спектрометр был откалиброван соответственно процедуре, предложенной в [4]; при этом отклонения составляли 0.05 эВ.

2. Результаты и их обсуждение

На рис. 1, 2 показаны фотоэлектронные спектры линий O (1s) и Y (3d) в зависимости от длительности ионной бомбардировки. Видно, что зарядка поверхности изменяется во времени. Поэтому для коррекции спектров были использованы следующие линии: сначала C (1s) (285.0 эВ), а после ее исчезновения Y ($3p_{1/2}$) (300.8 эВ), Y ($3d_{1/2}$) (157.5 эВ) и O (1s) (530.0 эВ).

Как видно из рис. 2, до бомбардировки у линии кислорода O (1s) лучше выражен выступ области высоких энергий связи E_{cb} . Вероятнее всего это связано с существованием OH⁻ групп. Выступ в области низких энергий — это кислород, связанный с диафрагмой из tantalа; он постепенно исчезает под действием ионной бомбардировки.

На рис. 1 показаны аналогичные спектры для линии Y (3d). Никаких изменений для линии Y (3d) во время ионной бомбардировки не было обнаружено. Из этого следует, что в данном случае иттрий не меняет своей валентности.

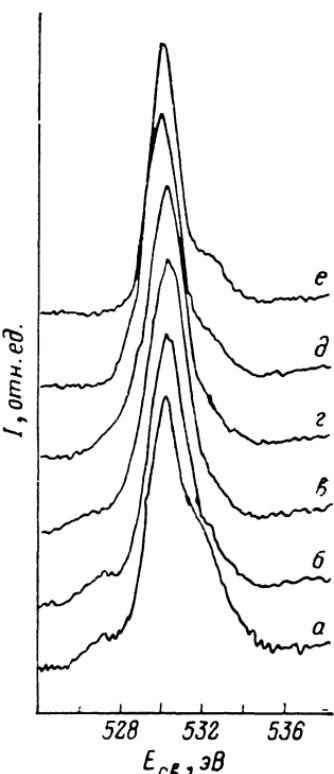


Рис. 2. РПЭС спектры линии O (1s) на поверхности пленки ЖИГ до (a) и после ионной бомбардировки в течение 1 (b), 10 (c), 26 (d), 60 (e), 120 мин (e).

Наиболее изменение претерпевают спектры железа, которые сни-
мались для линии Fe ($2p_{3/2}$) (рис. 3). В начале эксперимента наблюдался
пик, характерный для Fe^{3+} (рис. 3). В результате ионной обработки пик
в линии смещается в область более низких энергий. Это свидетельствует
о появлении на поверхности новых состояний Fe^{2+} и Fe^0 , причем эти со-
стояния возникают после первой минуты ионной обработки. Подобное
явление наблюдается на спектрах линии Fe ($3p$) (рис. 4). Однако по этим
спектрам не удается проследить изменение химических связей вследствие

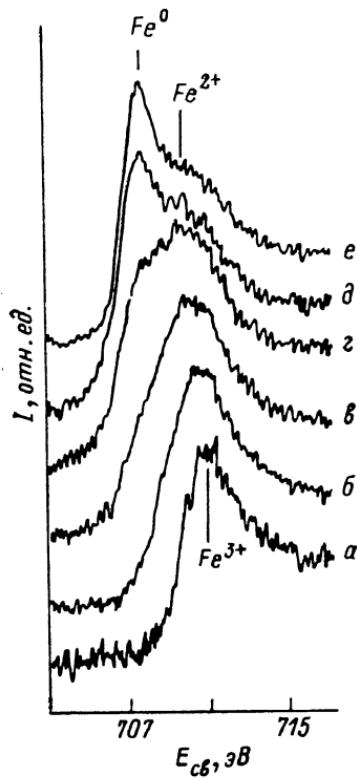


Рис. 3. РПЭС спектры линии Fe ($2p_{3/2}$) на поверхности пленки ЖИГ до (а) и после ионной бомбардировки в течение 1 (б), 10 (с), 26 (д), 60 (е), 120 мин (ж).

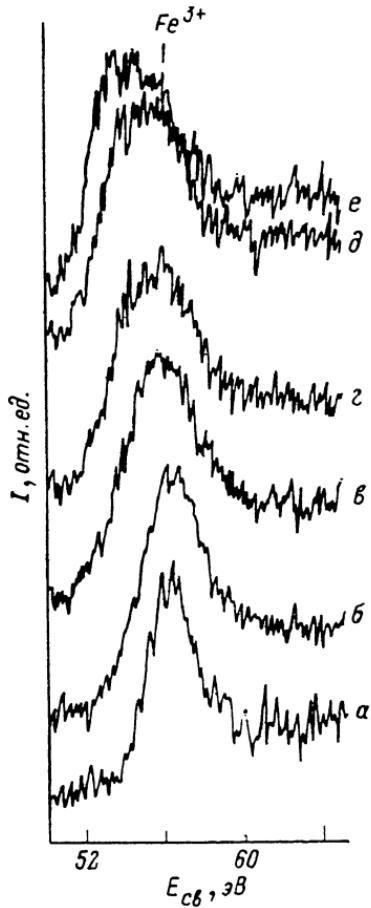


Рис. 4. РПЭС спектры линии Fe ($3p$) на поверхности пленки ЖИГ до (а) и после ионной бомбардировки в течение 1 (б), 10 (с), 26 (д), 60 (е), 120 мин (ж).

неразделимости дублета Fe ($3p_{3/2}$) Fe ($3p_{1/2}$). На основе анализа приведенных спектров Fe ($2p_{3/2}$) можно утверждать, что концентрация Fe^0 непре-
рывно растет и достигает насыщения при дозах не менее 10^{17} см^{-2} . По вы-
полненной оценке после 26 мин ионной обработки (доза $2.7 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$)
на поверхности около 50 % железа находится в состоянии Fe^0 (рис. 3).
Можно заметить, что в линии Fe ($2p_{3/2}$) пик Fe^0 выражен сильнее, чем
в линии Fe ($3p$), и предположить наличие градиента концентрации Fe^0 ,
направленного к поверхности в слое толщиной порядка 20 Å. Этот вывод
основан на различии глубин анализа при возбуждении линий Fe ($2p_{3/2}$)
и Fe ($3p$). В первом случае кинетическая энергия электронов меньше и глу-
бина анализируемого слоя не превышает 10 Å. Во втором случае глубина
анализа не больше 20 Å [5].

По интенсивностям линий рассмотренных спектров была построена
зависимость изменения относительной концентрации химических элемен-

тов пленки (рис. 5). После удаления экранирующего слоя углерода (начальный участок) наблюдается уменьшение концентрации кислорода и железа при одновременном уменьшении концентрации иттрия. Этот результат соответствует известным представлениям о преимущественном распылении более легких компонентов. Резкое нарастание концентрации железа на начальном участке до удаления слоя углерода и отсутствие такого нарастания для иттрия, по-видимому, связаны с меньшим пробегом электрона Fe ($2p_{3/2}$) (энергия 550 эВ) по сравнению с электроном Y ($3d$) (1100 эВ). Это допущение возможно, поскольку интенсивность линии Fe ($3p$) (1200 эВ) не имеет на начальном участке резкого нарастания. В остальном ее поведение аналогично линии Fe ($2p_{3/2}$). Переходный процесс изменения относительных концентраций элементов заканчивается после 26 мин ионной бомбардировки. За это время распыляется слой пленки

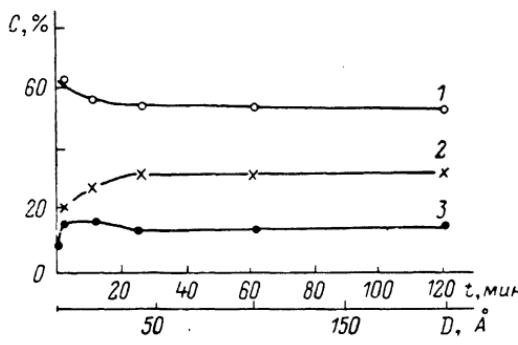


Рис. 5. Распределения элементов O, Y, Fe по глубине пленки ЖИГ, полученные по спектрам линий O (1s) (1), Y (3d) (2), Fe ($2p_{3/2}$) (3).

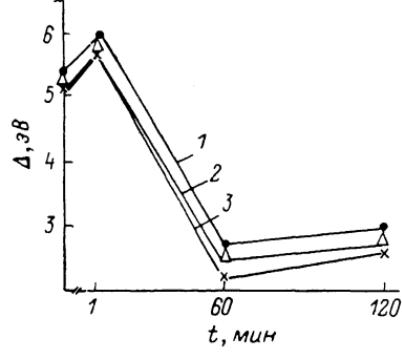


Рис. 6. Изменение энергетического сдвига линий Y ($3d_{3/2}$) (1), Y ($3p_{3/2}$) (2), O (1s) (3) во время ионной бомбардировки пленки ЖИГ.

толщиной порядка 40 Å. Согласно [3], можно утверждать, что толщина слоя с измененной стехиometрией вследствие преимущественного распыления имеет тот же порядок.

Можно отметить еще одну особенность, которая следует из рис. 5. В анализируемом поверхностном слое, толщина которого не превышает 20 Å, в установившемся режиме в результате ионной бомбардировки стехиометрический состав пленки граната $Y_3Fe_5O_{12}$ сильно изменяется. Этот результат может быть связан не только с эффектом преимущественного распыления. В немалой степени это, вероятно, обусловлено следующими причинами.

Иттрий, содержащийся в сложных соединениях, способен к образованию не только оксида Y_2O_3 , но и гидрооксида $YO(OH)$ [6, 7]. Причем если поверхность находится в гидрооксидной среде, что вполне возможно в подготовительной камере установки, где вакуум существенно ниже, то возможна интенсивная миграция иттрия из объема к поверхности.

Особенности спектра линии Fe ($2p_{3/2}$) таковы, что в области высоких энергий существует фон, обусловленный сателлитными структурами и процессом упругих потерь в твердом теле. В связи с этим в результаты вносятся систематическая ошибка, занижающая интенсивность линий железа.

На рис. 6 показано изменение энергетического сдвига для различных линий спектра РФЭС, которое возникает в результате ионной обработки. Уменьшение сдвига связано с уменьшением зарядки поверхности. Вероятнее всего это связано с возрастанием поверхностной проводимости из-за увеличения концентрации атомарного железа. Этот результат соответствует работе [8], где исследовано влияние изменения поверхностной проводимости пленок ЖИГ в результате ионной обработки.

На основе изложенного можно сделать выводы.

1. Ионная бомбардировка пленок ЖИГ ионами аргона Ar^+ с энергией 1 кэВ вызывает изменение состояния ионов железа. После окончания

ионной обработки на поверхности пленки обнаружено железо в состояниях Fe^{3+} , Fe^{2+} , Fe^0 . Относительная доля атомарного железа на поверхности (после дозы $2.7 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$) составляла величину порядка 50 %. Отмечен также градиент концентрации в слое толщиной порядка 20 Å.

2. Состояние ионов иттрия и кислорода заметно не изменяется.

3. Ионная обработка приводит к возникновению поверхностного слоя с измененной стехиометрией, в котором повышается содержание иттрия и снижается содержание железа и кислорода.

4. На поверхности пленок ЖИГ возможно присутствие соединений типа $\text{Y}_2\text{O}_3 + \text{YOON}$, которые приводят к увеличению поверхностной концентрации кислорода и иттрия.

5. С увеличением дозы ионной обработки возрастает поверхностная проводимость пленки.

Список литературы

- [1] Гласс Х. Л. // ТИИЭР. 1988. Т. 76. № 2. С. 64—85.
- [2] Исхок В. С. // ТИИЭР. 1988. Т. 76. № 2. С. 86—98.
- [3] Распыление твердых тел ионной бомбардировкой / Под ред. Р. Бериша. М.: Мир, 1986. С. 78.
- [4] Seah M. P., Anthony M. T. // Surf. Interface Anal. 1984. V. 6. P. 230—234.
- [5] Tanuma S., Powell C. J., Penn D. R. // Surf. Sci. 1987. V. 192. P. L849—L854.
- [6] Нефедов В. И. Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений. М.: Химия, 1984. С. 151.
- [7] Barr T. L. // J. Phisical Chemistry. 1978. V. 82. P. 1801—1806.
- [8] Боржонский В. Н., Евстафьев И. Г. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. № 1. С. 80—82.

Ленинградский электротехнический
институт им. В. И. Ульянова (Ленина)
Ленинград

Поступило в Редакцию
7 февраля 1989 г.